⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-123829

⑤Int Cl.⁴

識別記号

3 5 6

厅内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)5月27日

C 03 B 37/018 20/00

C-6674-4G 7344-4G

// G 02 B 6/00

A-7370-2H 審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

国発明の名称

光ファイバ用母材の製造方法

20特 昭61-265520 阋

29出 昭61(1986)11月10日

⑫発 明 者 瀬 戸

之 克

千葉県佐倉市六崎1440番地 藤倉電線株式会社佐倉工場内 千葉県佐倉市六崎1440番地 藤倉電線株式会社佐倉工場内

千葉県佐倉市六崎1440番地 藤倉電線株式会社佐倉工場内

東京都江東区木場1丁目5番1号

@発 明 者 田中 大一郎 ⑫発 明。者 山内 良 三

の出 顋 藤倉電線株式会社 人 砂代 理 人 弁理士 竹 内

1. 発明の名称

光ファイバ用母材の製造方法

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) ガラス棒からなる中心部材の外表面に燃料 ガスとともに気相反応用原料ガスを吹き付け 火炎加水分解反応させることによりガラス微 粒子を合成し、該微粒子を上記中心部材の外 周上に同心状に堆積させ、高温にて加熱処理! . することにより透明ガラス化する光ファイバ 用母材の製造方法において、上記燃料ガスと 原料ガスを吹き付けガラス微粒子を堆積させ る工程が、水素を含まない燃料ガスと原料ガ スを吹き付けてガラス微粒子を堆積させる第 1工程と、水索を含む燃料ガスと原料ガスを 吹き付けてガラス放粒子を堆積させる第2工 程からなることを特徴とする光ファイバ用母 材の製造方法。
- (2) 上記の水素を含まない燃料ガスと原料ガス を吹き付けてガラス微粒子を堆積させて形成

するスート層の厚さが10mm以上である特許請 求の範囲第1項記載の光ファイバ用母材の製 造方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は通信用光ファイバ用母材の製造方法に 関するものである。

(従来の技術)

光ファイバ用母材を造るのに、光ファイバのコ アとなる透明なガラス棒の外周に、気相反応を利 用して光ファイバのクラッドとなるガラス微粉末 (スート)を堆積させ加熱炉内にて焼成して光フ ァイバ用母材とする方法がある。この方法は光フ ァイパのコアとなる石英ガラス棒からなる中心部 材を回転しながら該石英ガラス棒の外周に酸水素 炎とともにガラス原料である SiCla等を気相状態 でキャリヤガス02とともに吹き付けると、このガ ラス形成原料ガスは(1)式に示す火炎加水分解 反応を起こし、SiOz等の酸化物ガラス微粒子 (ス ート)が石英ガラス棒に付着、堆積して多孔質の

スート層が形成され、これを脱水・焼結・延伸し て透明化された光ファイバ母材を得るものであり、

$$2H_{z} + 0_{z} \rightarrow 2H_{z}0$$

 $SiCl_4 + 2H_2O \rightarrow SiO_2 + 4HC1$ (1)

また、更に必要に応じて該母材の上にもう一度同様に酸水素炎でスートを堆積させてこれを脱水・ 焼結・延伸して透明な光ファイバ母材を得る。

しかし、この反応系では未反応のH2が中心部材の中に拡散して0H基となって残留し0H基吸収による損失増の原因となることがよく知られている。そこで、この0H基による損失を低減させるために、酸水素炎の代わりに水素を含まない燃料の火炎を用いてスート層を形成する方法が提案されている。例えば(2)式による。

SiCla+Oz - SiOz + 2Clz

(2)

また、CS』を利用した例もある。

(発明が解決しようとする問題点)

上記の如く気相反応を利用して光ファイバ母材 を造る製造方法において、酸水素炎を用いる場合

る。

上記の光ファイバ用母材の製造方法によれば、中心部材の上に、まず、水素を含まない火炎を用いてスート層を形成するのでこの工程での0 H 基の拡散は避けられる。また、外側に酸水素炎を用いてスート層を形成する工程での0 H 基は内部に拡散はするが、内側のスート層の厚さが厚くなるほど0 H 基の中心部材への拡散吸収は少なくなり、この厚さが10mm以上あればほぼ避けることができる。

(実施例)

中心部材として VAD法で製造され脱水を十分に行い所定の外形に延伸されたのち衷面をプラズマ炎による火炎研磨と六ふっ化硫黄 (SF。)によるエッチング処理がなされた透明なガラス棒を用い、この中心部材の外周に水素を含まないCOによる火炎でスートを堆積して外径を35mmとした。そは積して外径を約100mm とし、これを脱水・焼結・延伸・表面処理を行なって外径12mmの透明な単一モ

は0 H基による吸収損失により特に長波長帯において伝送損失が大きくなるという問題があり、この残存0 H基を如何に減らすかが重要な技術的よる 既となっている。また、前記の如く0 H基に料める 吸収損失を減らすために水素を含まない燃料のよる 炎を用いる場合は火力が弱いためにスートの堆積 速度が酸水素炎の場合に比べて1/10と遅くなり、 柔らかいスートが堆積しやすく、スート層が削れ やすく、また、火力調整が難しいなどの難点がある。

(問題点を解決するための手段及び作用)

本発明は、上記の如き問題点を解決するためになされたもので、まず中心部材の透明なガラスでの外間に、第1工程として例えばCO、CS。、プラスを含まない火炎を用いて後させ、第2工程として必要な方法によりスートを堆積させることによってクラッドに相当であるを増減させることによってクラッドに相当である形成した光ファイバ母材を製造するものである。

ード光ファイバ用母材を得た。この母材を線引して光ファイバとし、 0 H 基による吸収損失を測定したところ波長 1.38 mにおいて 5 dB/kmであり、1.55mにおいては 0.20 dB/km であった。

比較例として、上記と同様な中心部材の外間に 酸水素炎でスートを堆積させ外径を約100mm とし、 これを脱水・焼結・延伸し、上記と同様な火炎研 磨およびエッチング処理して外径12mmの透明なガ ラス棒とし、更に、この透明なガラス棒の外間に もう一度酸水素炎でスートを堆積させ、同様に脱水・焼結を行い単一モード光ファイバ母材を製造 し、線引して光ファイバとし、0 H基による吸収 損失を測定したところ波長 1.38 mmにおいて 20 dB/km であった。

上記の如く被長 1.38 mにおける 0 H基による 吸収損失は実施例は従来例としての比較例と比べ て約1/4 と小さくなっている。

なお、中心部材としてはGeドープシリカ、純粋 シリカ、微量のFドープシリカであってもよい。

(発明の効果)

本発明による光ファイバ母材の製造方法によれば、前記のとおり光ファイバの導波部であるコアとなる中心部材への 0 H 基の拡散を避けることができるので光ファイバの 0 H 基による吸収損失が極めて小さくなり、従って伝送損失が小さくなりという効果がある。また、水素を含まない燃料による火炎でスートを堆積させるので、スートを堆積させるので、スートの堆積速度の遅れといった課題も解消され、前記の如くスート層の割れを生ずることもない。

代理人 弁理士 竹内 守